

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)										外形	備考
				V_{ceo} (V)	V_{cso} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{cso} 最大値 (μA)	$V_{ce(V)}$	直流又はパルス h_{FE} I_c (mA)	バイアス $V_{ce(V)}$	h_{FE} h_{FE} *	h_{ie} h_{ie} * (Ω)	h_{re} h_{re} * ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe} * (μS)	f_{α} f_{α} * (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $r_{bb'}$ (real)* (Ω)	
1	2	3	4	5					6	7		8			9			10	11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I_{cso} MAXIMUM VALUE AND V_{ce} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{cso})
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{ce} , I_c (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{ce} , I_c (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

- 9 f_{α} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T .
- 10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11 OUTLINE
- 12 REMARKS

: とコンプリ: COMPLEMENTARY TO

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 (T _a = 25℃)					電 気 的 特 性 (T _a = 25℃)													外 形	備 考
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _J (℃)	I _{CB0} 最大値		直 流 又 は パ ル ス hFE		バ イ ア ス		h _{fe} h _{fb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ie} (real)* (Ω)		
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)									
2SD1137	日 立	PA	Si.T	100	4	4 A	40W (T _c =25℃)	150	10	100	120	4	500									268	
" 1138 "	"	"	"	200	6	2 A	30W (T _c =25℃)	150	1	120	140	4	50									268	
" 1139 "																							
" 1140 東 芝	SW		Si.E	30	10	1.5A	900	150	10	30	7000	2	150		t _{on} < 0.4 μS, t _{off} < 1.2 μS						241	ターリントン	
" 1141 "																							
" 1142 "																							
" 1143 "																							
" 1144 "																							
" 1145 三 洋	AF.SW		Si.EP	60	6	5 A	900	150	1	50	100~560	2	500	10	-50				120 *	45	294		
" 1146 "																							
" 1147 富士電機	PA		Si.TP	120	6	5 A	30W (T _c =25℃)	150	1 mA	120	5000	5	1 A	5	-500				22 *	54	268	ターリントン	
" 1148 東 芝	"		Si.T	140	5	10A	100W (T _c =25℃)	150	5	140	100	5	1 A								203		
" 1149 松 下	AF		Si.EP	100	15	20	200	125	1	60	1000	10	2									176	
" 1150 三 洋	SW		"	350	6	6 A	40W (T _c =25℃)	150	100	40	60	5	3 A		t _f < 1 μS						268	水平偏向用	
" 1151 松 下	"		Si.TMe	1500	5	5 A	95W (T _c =25℃)	130	100	750	40~150	10	3.5A		t _{sig} < 7 μS, t _f < 1 μS						102	ターリントン デンソウ内蔵	
" 1152 日 立	AF		Si.E	55		100	200	125	0.5	18	500	12	2								138		
" 1153 三 洋	AF.SW		Si.EP	80	10	1.5A	900	150	0.1	40	>4000	2	500	10	-50				120 *		294	253B05 ヒコシアリ (ターリントン)	
" 1154 "																							
" 1155 富士電機	SW		Si.TP	400	6	50A	300W (T _c =25℃)	150	1 mA	400	400	5	50A		t _{on} < 2 μS, t _{off} < 2.5 μS t _{sig} < 10 μS						254	ターリントン	
" 1156 "																							
" 1157 富士電機	AF.PA		Si.TP	80	10	4 A	25W (T _c =25℃)	150	100	80	400	5	500									268	
" 1158 "	AF.PA.SW	"	"	80	10	8 A	40W (T _c =25℃)	150	100	80	400	5	1 A		t _{on} < 0.5 μS, t _{off} < 3 μS						268		
" 1159 "																							
" 1160 "																							
" 1161 "																							
" 1162 日 電	SW		Si.T	500	10	10A	40W (T _c =25℃)	150	10	400	400~3000	2	2 A		t _{on} = 1 μS, t _{off} = 12 μS t _{sig} = 12 μS						268	ターリントン	
" 1163 日 立	"		"	300	6	7 A	40W (T _c =25℃)	150	5 mA	300	40	5	5 A		t _f < 0.5 μS						268	水平偏向用	
" 1164 "																							
" 1165 "																							
" 1166 "																							